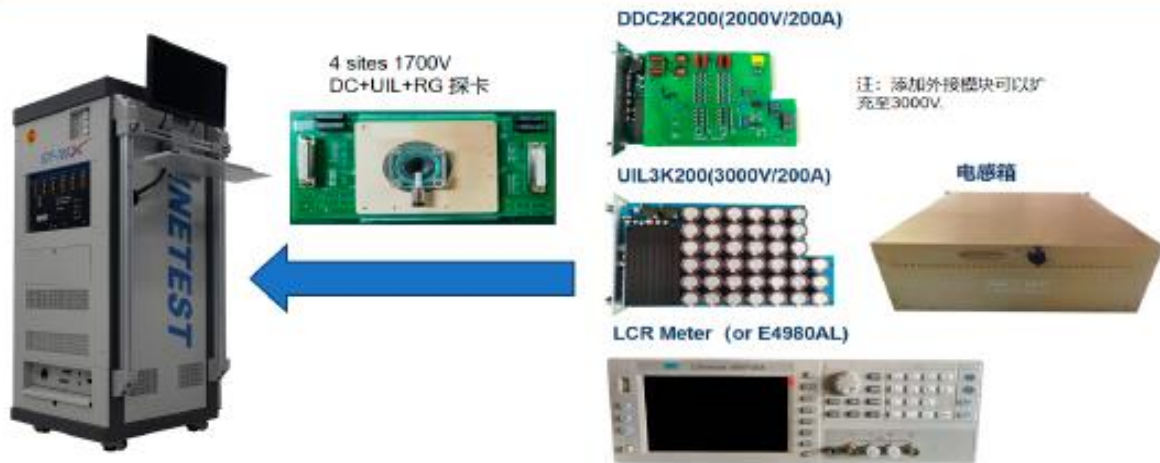


# SiC/GaN晶圆测试方案 (含KGD)

## 业内最高UPH, 轻易实现更多工位测试

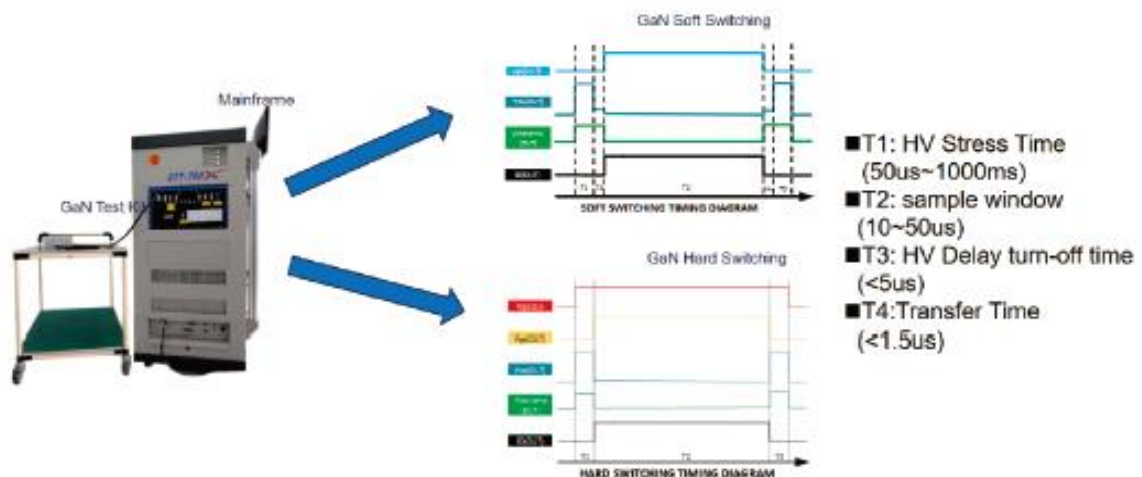
### SiC Wafer Test Case Study

SiC-SBD, SiC-MOSFET (>1000V)



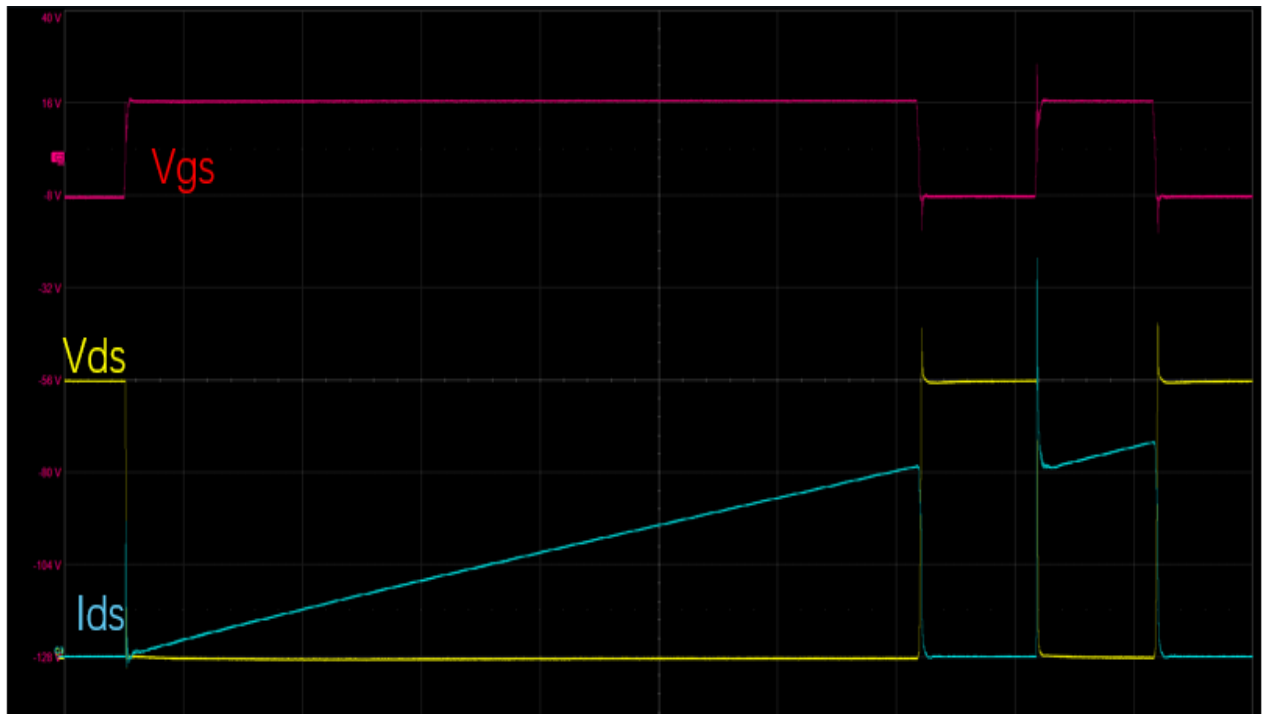
### Dynamic Test Module

GaN Test Solution – DC + Soft/Hard Switching DRON

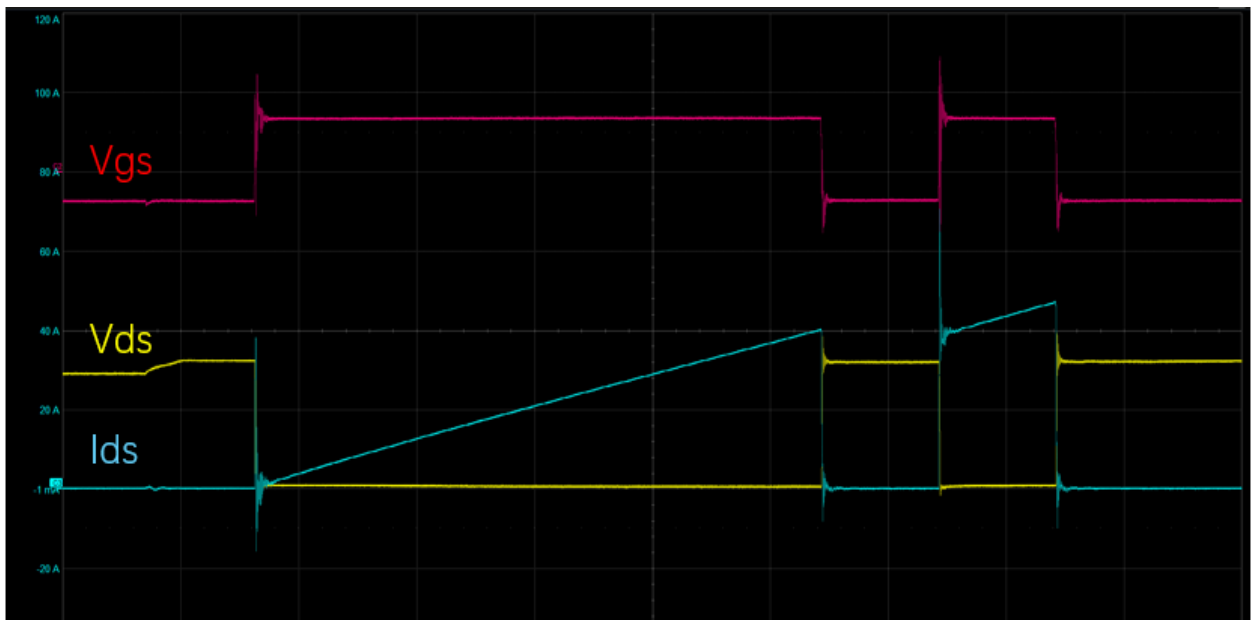


GaN支持多种测试模式, 兼容MOS/BJT/FRD等4site测试; 具有硬件防呆, 兼容16site probe card测试; 支持多晶电阻测试, 支持Drain电极与buffer缓冲层结构间的漏电流。

## SIC/IGBT 部分开关参数测试波形图（双脉冲）：



上图为 IGBT 样品双脉冲测试波形，部分开关参数如 Tdon 为 12.7ns，Trr 为 259.9ns



上图为 SIC 样品双脉冲测试波形，部分开关参数如 Tdon 为 15.2ns，Trr 为 61.4ns

二极管反向恢复时间 Trr 和短路电流 (Isc) 的波形图这里没有展示，如对其它开关参数的测试感兴趣，请联系我们!

注：样品为 TO247 封装，杂散电感<30nH.